

SOT223 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR

FZT657

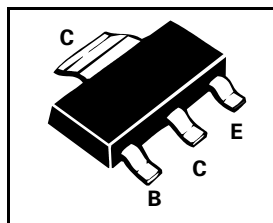
ISSUE 3- FEBRUARY 1995

FEATURES

- * Low saturation voltage

COMPLEMENTARY TYPE - FZT757

PARTMARKING DETAIL - FZT657



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	300	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	300	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	1	A
Continuous Collector Current	I_C	0.5	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

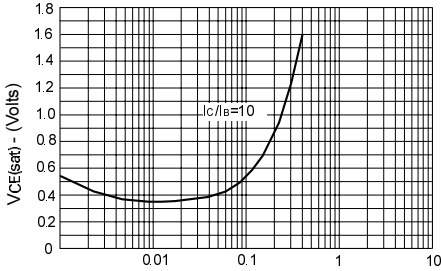
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	300			V	$I_C=100\mu A$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	300			V	$I_C=10mA^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			0.1	μA	$V_{CB}=200V$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			0.1	μA	$V_{EB}=3V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.5	V	$I_C=100mA, I_B=10mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			1.0	V	$I_C=100mA, I_B=10mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			1.0	V	$I_C=100mA, V_{CE}=5V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	40 50				$I_C=10mA, V_{CE}=5V^*$ $I_C=100mA, V_{CE}=5V^*$
Transition Frequency	f_T	30			MHz	$I_C=10mA, V_{CE}=20V$ $f=20MHz$
Output Capacitance	C_{obo}			20	pF	$V_{CB}=20V, f=1MHz$

*Measured under pulsed conditions. Pulse Width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$
Spice parameter data is available upon request for this device

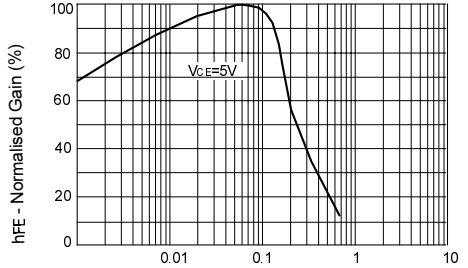
FZT657

TYPICAL CHARACTERISTICS



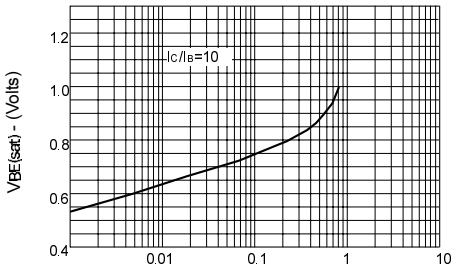
I_C - Collector Current (Amps)

$V_{CE(sat)}$ v I_C



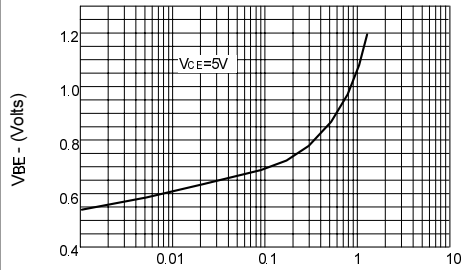
I_C - Collector Current (Amps)

h_{FE} v I_C



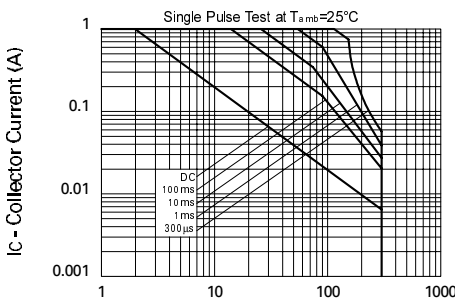
I_C - Collector Current (Amps)

$V_{BE(sat)}$ v I_C



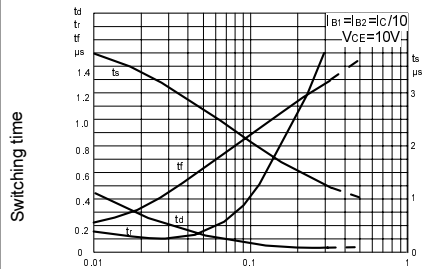
I_C - Collector Current (Amps)

$V_{BE(on)}$ v I_C



V_{CE} - Collector Emitter Voltage (V)

Safe Operating Area



I_C - Collector Current (Amps)

Switching Speeds



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.